

**L、MOSFET 型号命名规则**

AP200N04TLG5							
<u>AP</u>	<u>    </u>	<u>200</u>	<u>N</u>	<u>04</u>	<u>    </u>	<u>TL</u>	<u>G5</u>
1	2	3	4	5	6	7	8
序号	解析	编码		解析			
1	简称	AP/APM		A Power Microelectronics (永源微电子) 缩写			
2	工艺制程	留空		沟槽工艺和平面工艺			
		G		屏蔽栅工艺			
		J		超结工艺			
		D		耗尽型			
3	额定电流			数字前加“0”表示小数点			
4	沟道	N		N 沟道			
		P		P 沟道			
		H		N+N 沟道			
		V		P+P 沟道			
		G		N+P 沟道			
5	额定电压			实际耐压等于：数值*10			
6	版本号	A/B/C/D/E		不同版本号			
7	表示封装形式	I		SOT23LL			
		MI		SOT23-3L			
		LI		SOT23-6L			
		SI		SOT89-3L			
		MSI		SOT223-3L			
		D		TO252-3L			
		Y		TO251-3L			
		GD		TO252-4L			
		F		TO220F-3L			
		P		TO220-3L			
		T		TO263-3L			
		T6		TO263-6L			
		MP		TO247-3L/TO247-3L PLUS			
		S		SOP-8L			
		ES		ESOP-8L			
		TS		TSSOP-8L			
		AF		QFN3*3-8L			
		BF		QFN2*2-6L			
		CF		QFN2*3-6L			
DF		PDFN3*3-8L					
		NF/ NF2		PDFN5*6-8L/ PDFN5*6-8L 上下架构			
		TL		TOLLA-8L			
8	工艺等级	G5		SGT 第五代			